

	<p><b>SI4973DY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4973DY-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI4973DY-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







### Spezifikationen

Teilenummer	SI4973DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7.6A, 10V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 5.8A 1.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A
Basisteilenummer	SI4973

SI4973DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4973DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4973DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4973DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4973DY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8SOIC</p>	 <p><b>SI4973DY</b> VISHAY SI4973DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4973DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4976DY</b> VISHAY SI4976DY VISHAY</p>
 <p><b>SI4973DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 30V 5.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4974DY</b> VISHAY SI4974DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4974DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6A 8-SOIC</p>	 <p><b>Si4974ADY-T1-E3</b> VISHAY SI4974ADY-T1-E3 VISHAY</p>

### SI4973DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Suchbegriff	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4973DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4973DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4973DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4973DY-T1-GE3
SI4973DY-T1-GE3 Electronic	SI4973DY-T1-GE3 Hersteller	SI4973DY-T1-GE3 Komponenten	SI4973DY-T1-GE3 Verteiler	SI4973DY-T1-GE3 Bild	SI4973DY-T1-GE3 Teil
SI4973DY-T1-GE3 Preis	SI4973DY-T1-GE3 Original	SI4973DY-T1-GE3 Neu	SI4973DY-T1-GE3 garantiert	SI4973DY-T1-GE3 RFQ	SI4973DY-T1-GE3 Inventar
SI4973DY-T1-GE3					SI4973DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited